



【800～900万円】SiCエピタキシャル成長プロセス開発エンジニア [53044]

ルネサス エレクトロニクス株式会社での募集です。 プロセスエンジニア（半導体）...

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

ルネサス エレクトロニクス株式会社

求人ID

1488137

業種

電気・電子・半導体

雇用形態

正社員

勤務地

愛媛県

給与

800万円～900万円

勤務時間

08:30～17:15

休日・休暇

【有給休暇】初年度23日1か月目から【休日】完全週休二日制 土日 祝日 夏季休暇 年末年始【有給休暇】入社月に付与（...）

更新日

2025年01月03日 15:00

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

ビジネス会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

大学卒：学士号

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2133826】

【担当技術】

SiCエピタキシャル成長プロセス開発エンジニア

【担当業務】

SiCエピタキシャル成長装置立ち上げ、プロセス条件出し、量産化

【担当職場】

自社前工程国内拠点

スキル・資格

【MUST】

SiCエピタキシャル成長プロセス開発の従事経験が2年以上あること。

【WANT】

4年制大学または大学院にて工学、化学、物理学等を修了していること。

会社説明

各種半導体に関する研究、開発、設計、製造、販売およびサービス